## DC DESIGNFORLØB

#### **Effektforsyningen**

Effektforsyningen planlægges med start ved udgangen. Ved en effekt på 30W i  $8\Omega$  skal udgangsspændingen være  $V_{O\ RMS}$  = 15,5V med amplituden  $V_{O}$  = 22V. Der skal være plads til to basis-emitter strækninger for udgangstrinnet, noget lignende til den øvrige elektronik og ripple i effektforsyningen og 10% på netspændingen så effektforsyningen bør placeres cirka 5V højere end kravet til  $V_{O}$  og det giver værdien til +-27V.

$$P_O \coloneqq 30 \; \boldsymbol{W}$$
  $R_L \coloneqq 8 \; \boldsymbol{\Omega}$ 

$$P_O = \frac{{V_{rms}}^2}{R_L} \qquad V_{rms} \coloneqq \sqrt{P_O \cdot R_L} = 15.49 \text{ V}$$

$$V_O := V_{rms} \cdot \sqrt{2} = 21.91 \ \boldsymbol{V}$$

$$V_{CC} = 1.1 \cdot 22 \ V + 2 \cdot 0.7 \ V + 2 \cdot 0.7 \ V = 27 \ V$$

$$V_{EE} = -V_{CC} = -27 \ V$$

#### Strømniveauet

Strømniveauet i udgangstrinnet estimeres. Med  $8\Omega$  som den nominelle belastning bør der tages udgangspunkt i  $R_L = 6\Omega$  da en højttaler har en svingspole der har en DC modstand  $R_{DC}$  på typisk 80% af den nominelle værdi.

Strømmens spidsværdi bliver  $I_{OPEAK}$  = 3,65A og der må forventes en middelstrøm fra effektforsyningen på  $I_{DC}$  = 1,16A. Hvis den værdi holder så bliver den tilførte effekt på 67W ved 30W afgivet i nominelt 8 $\Omega$  og virkningsgraden er 45%.

$$R_L \coloneqq 6 \Omega$$

$$I_{OPEAK} \coloneqq \frac{V_O}{R_L} = 3.65 \; \textbf{\textit{A}}$$

$$I_{DC} \coloneqq \frac{I_{OPEAK}}{\pi} = 1.16 \ A$$
 loc half wave

$$P_{CC}\!\coloneqq\!V_{CC}\!\cdot\!\left(\!I_{O\!P\!E\!A\!K}\!-\!I_{D\!C}\!\right)\!=\!67.21\;\pmb{W}$$

$$\eta \coloneqq \frac{P_O}{P_{CC}} \cdot 100 = 44.64$$

#### **Effekttabet**

Effekttabet i udgangstransistorerne  $T_{10}$  og  $T_{11}$  bliver 24W samlet og derfor forventes et tab på 12W i hver transistor. Det danner udgangspunktet for en senere beregning af køleprofilen.

$$P_T \coloneqq \left(\frac{2}{\pi}\right) \frac{V_{CC} \cdot V_O}{R_L} - \frac{{V_O}^2}{2 R_L} = 22.76 \ \textbf{W} \qquad \qquad P_T \coloneqq 0.4 \cdot \frac{{V_{CC}}^2}{2 R_L} = 24.3 \ \textbf{W}$$

#### **Drivertrinnet**

Drivertrinnet skal levere basisstrømmen til udgangstransistorerne 2N3055 og MJ2955 og med  $\beta_{10}$  =  $\beta_{11}$  = 20 som strømforstærkning i  $T_{10}$  og  $T_{11}$  behøves en strøm på 183mA så der afsættes 1/20 af effekttabet i drivertransistorerne  $T_8$  og  $T_9$  eller 0,6W i hver transistor.

Man bør være meget konservativ og dimensionere efter en transistor der kan håndtere mindst 1W da effekten varierer som funktion af udgangsspændingen. Der bruges en transistor på 10W uden et køleprofil og ellers må man planlægge køling af disse transistorer.

$$\beta_{10} = 20$$

$$I_B \coloneqq \frac{I_{OPEAK}}{\beta_{10}} = 182.57 \,\, \textit{mA}$$

$$P_{TO} = \frac{P_T}{20} = 1.22 \ W$$

$$P_{T9} = \frac{P_{TO}}{2} = 0.61 \ W$$

#### <u>Basisstrømmen</u>

Basisstrømmen til drivertrinnet er 5 mA ved en strømforstærkning på  $\beta_8 = \beta_9 = 40$ .

$$\beta_8 = 40$$

$$I_B \coloneqq \frac{183 \ \textit{mA}}{\beta_8} = 4.58 \ \textit{mA}$$

Modstanden RE (R7) i strømkilden

$$I_{C} = \frac{U_{BE}}{R_{E}} \xrightarrow{solve\,,R_{E}} \frac{U_{BE}}{I_{C}}$$

$$R_E \coloneqq \frac{0.7 \ V}{20 \ mA} = 35 \ \Omega$$

#### <u>Indgangstrinnet</u>

Indgangstrinnet skal levere basisstrømmen til  $T_5$  som med  $\beta_5$  = 420 er på 25  $\mu$ A. Der bør vælges en mange gange højere strøm i den fælles emitter for at holde differentialtrinnets balance nær ved fifty-fifty så strømmen vælges til  $I_E$  = 5 mA. Det indstilles ved modstanden  $R_E$  til 5,1k $\Omega$ .

$$I_E \coloneqq 5 \, mA$$

$$R_E\!\coloneqq\!\frac{27\;V\!-\!0.7\;V}{I_E}\!=\!5.26\;\boldsymbol{k\Omega}$$

$$R_E \coloneqq 5.1 \ \boldsymbol{k\Omega}$$

## Forstærkningen

Forstærkningen indstilles så fuld udstyring på  $V_0$  RMS = 15,5 V opnås ved ved  $V_1$  RMS = 0,5 V på indgangen og indstilles af  $A_{CL} = 1 + R_6/R_5 = 31$ . Et valg af  $R_3 = 1$  k $\Omega$  giver  $R_4 = 30$  k $\Omega$ .

$$A_{CL} = \frac{15.5}{0.5} = 31$$

$$R_3 \coloneqq 1 \ \boldsymbol{k\Omega}$$

$$A_{CL} = 1 + \frac{R_4}{R_3} \xrightarrow{solve, R_4} 30 \cdot k\Omega$$

# AC DESIGNFORLØB

#### Den lave grænsefrekvens

Den lave grænsefrekvens fastsættes af C₁ og R₂ til 1,6Hz og kondensator C₄ skal blot være "stor" så spændingsvariationen over den bliver "lille" i sammenligning med værdien over R₅ for at holde forvrængningen nede. Det skyldes at en aluminium elektrolyt kondensator ikke er en lineær komponent. En typisk værdi på 100 µF giver 1,6 Hz.

$$C_1 \coloneqq 10 \ \mu \mathbf{F}$$
  $C_4 \coloneqq 100 \ \mu \mathbf{F}$ 

$$R_2 \coloneqq 10 \ \boldsymbol{k\Omega}$$
  $R_3 \coloneqq 1 \ \boldsymbol{k\Omega}$ 

$$f_1 \coloneqq \frac{1}{2 \; \boldsymbol{\pi} \cdot R_2 \cdot C_1} = 1.6 \; \boldsymbol{Hz}$$

$$f_2\!\coloneqq\!\frac{1}{2\;\pmb{\pi}\!\cdot\! R_3\!\cdot\! C_4}\!=\!1.6\;\pmb{Hz}$$

#### **Transkonduktansen**

Transkonduktansen gm i differentialtrinnet T<sub>1</sub> ... T<sub>4</sub> beregnes til 96mS.

$$I_E \coloneqq 5 \, \boldsymbol{mA}$$

$$U_T \coloneqq 26 \ mV$$

$$g_m := \frac{I_E}{2 \cdot U_T} = 0.096 \ S$$

## Åben-sløjfe forstærkningen

Åben-sløjfe forstærkningen beregnes fra transkonduktansen, strømforstærkningen i T₅ og indgangsmodstanden på udgangstrinnet ved basis af T₅ og T∍ der giver et estimat på Rc i formlen.

Indgangsmodstanden for en emitterfølger er belastningen R $_{L}$  gange med den samlede strømforstærkning til R $_{C}$  = 4,8 k $_{L}$  DC forstærkningen beregnes derefter til A $_{DC}$  = 194 000 ved en belastning på R $_{L}$  = 6  $_{L}$  .

$$\beta_8 = 40$$

$$\beta_{10} = 20$$

$$R_C := \beta_8 \cdot \beta_{10} \cdot 6 \Omega = 4.8 k\Omega$$

$$\beta_5 = 420$$

$$A_{DC} := g_m \cdot \beta_5 \cdot R_C = 193.8 \cdot 10^3$$

#### **Kompenseringen**

Kompenseringen skal sikre stabilitet ved at reducere forstærkningen til en ved den laveste af de høje poler der antages givet af  $R_c$  og  $C_\mu$  for  $T_5$ ,  $T_8$  og  $T_9$  i parallel.

Ved en værdi for  $C_{\mu}$  på 3 pF findes  $f_H$  = 11,1 MHz og den dominerende pol  $f_0$  findes til 14 Hz. Ved den aktuelle forstærkning på  $A_{CL}$  = 31 kan den dominerende pol  $f_P$  findes til 442 Hz som er tilstrækkelig for stabilitet.

Ved Miller-transformation findes modstande og kapaciteter, der resulterer i poler.

$$I_C \coloneqq \frac{27 \ V}{4.8 \ k\Omega} = 5.6 \ mA$$
  $r_C \coloneqq R_C$ 

$$g_{m5} \coloneqq \frac{I_C}{U_T} = 0.216 \ S$$

$$A \coloneqq g_{m5} \cdot R_C = 1038.5$$

$$r_{\pi 5} \coloneqq \frac{\beta_5}{g_{m 5}} = 1.9 \ \boldsymbol{k\Omega}$$

$$f_T \!\coloneqq\! \frac{300~\textit{MHz} \cdot I_C}{10~\textit{mA}} \!=\! 168.75~\textit{MHz}$$

$$C_{\pi 5} \coloneqq \frac{g_m}{2 \; \pi \cdot f_T} = 90.7 \; pF$$

#### *C*<sub>μ</sub> ≈ 1 ... 5 pF

$$C_{\mu 5}\!\coloneqq\! 3\ pF$$

$$C_{MO} \coloneqq C_{\mu 5}$$

$$C_{MI} := (1+A) C_{MO} = 3.1 \text{ nF}$$

Polen ved ind- og udgangen findes.

$$f_1 \! \coloneqq \! \frac{1}{2 \; \boldsymbol{\pi} \! \cdot \! r_{\pi 5} \! \cdot \! (C_{\pi 5} \! + \! C_{MI})} \! = \! 25.5 \; \boldsymbol{kHz}$$

$$f_2 \coloneqq \frac{1}{2 \; \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\cdot} r_C \boldsymbol{\cdot} C_{MO}} = 11.1 \; \boldsymbol{MHz}$$

Den nye dominerende pol findes ud fra den høje pol ved 11,1 MHz.

$$f_H = f_2$$

$$f_0 \leq \frac{f_H \cdot A_{CL}}{4 A_{DC}}$$

$$f_0 := \frac{f_H}{4 A_{DC}} = 14.3 \; Hz$$

Den dominerende pol kan hæves med forstærkningen Acl.

$$f_0 := \frac{f_H \cdot A_{CL}}{4 \ A_{DC}} = 441.9 \ Hz$$

Kompenseringskondensatoren kan nu vælges.

$$C_C \coloneqq \frac{1}{2 \; \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\cdot} f_0 \boldsymbol{\cdot} \beta_5 \boldsymbol{\cdot} R_C} = 178.7 \; \boldsymbol{pF}$$

$$C_C \coloneqq 180 \ pF$$

#### Slew rate

Slew rate værdien bliver SR = 28 V/ $\mu$ s der fuldt tilstrækkelig for musikformat som er begrænset til 2 V/ $\mu$ s ved frekvensen 20 kHz.

$$SR = 2 \pi \cdot f \cdot V_O = 2 \frac{V}{\mu s}$$

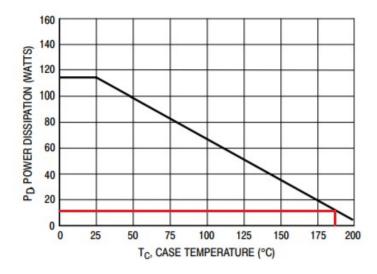
$$SR \coloneqq \frac{I_E}{C_C} = 27.8 \; \frac{\textit{V}}{\textit{\mu s}}$$

# **KØLEPROFIL**

#### **Chiptemperaturen**

Køleprofilet for udgangstransistorerne beregnes ud fra specifikationen af hvad temperaturen på transistorens chip må være ved 12 W afsat effekt. Det benævnes T<sub>j</sub> for *junction temperature*.

Chiptemperaturen må for 2N3055 maksimalt være 185°C ved 12 W afsat effekt, men man bør aldrig gå til grænsen så her fastsættes værdien konservativt til  $T_j = 100$ °C. Med en omgivelsestemperatur pa 25°C skal temperaturstigningen holdes nede på 75°C.



#### Den termiske modstand

Den termiske modstand fra junction til monteringsflade er 1,52°C/W ifølge databladet så kravet bliver omkring 4,7 °C/W for køleprofilets termiske modstand til omgivelserne (køleprofilets K værdi).

$$R_{thhs} = \frac{100 \ \textit{K} - 25 \ \textit{K}}{12 \ \textit{W}} - 1.52 \ \frac{\textit{K}}{\textit{W}} = 4.73 \ \frac{\textit{K}}{\textit{W}}$$

#### SOA

Maksimum ratings for 2N3055 er 115W, 60V og 15A.

Grænseværdierne bliver derfor:

$$\frac{115 \ W}{60 \ V} = 1.9 \ A$$

$$\frac{115 \ W}{15 \ A} = 7.7 \ V$$